

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 10 月 6 日 (06.10.2005)

PCT

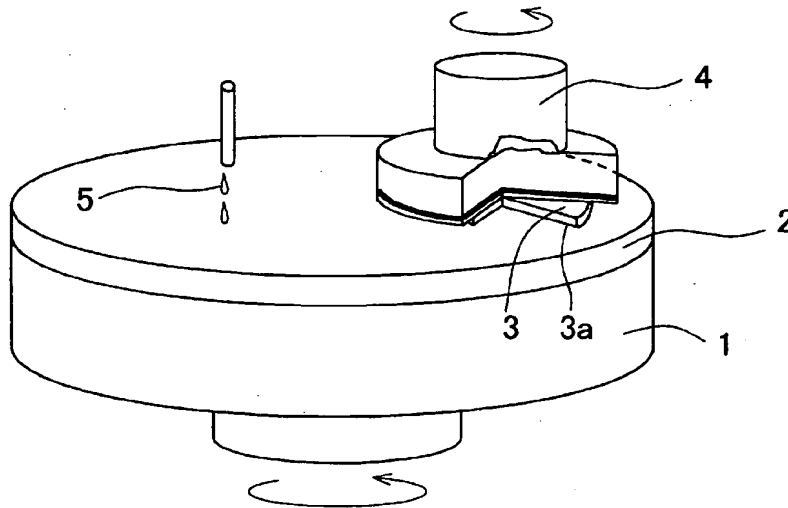
(10) 国際公開番号
WO 2005/093803 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/304 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/005767 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 太田 慶治 (OHTA, Yoshiharu) [JP/JP]; 〒6391032 奈良県大和郡山市池沢町 1 7 2 ニッタ・ハース株式会社 奈良工場内 Nara (JP). 板井 康行 (ITAI, Yasuyuki) [JP/JP]; 〒6391032 奈良県大和郡山市池沢町 1 7 2 ニッタ・ハース株式会社 奈良工場内 Nara (JP).
(22) 国際出願日: 2005 年 3 月 28 日 (28.03.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願2004-096848 2004 年 3 月 29 日 (29.03.2004) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ニッタ・ハース株式会社 (NITTA HAAS INCORPORATED) [JP/JP]; 〒5560022 大阪府大阪市浪速区桜川 4-4-2 6 Osaka (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

(続葉有)

(54) Title: COMPOSITION FOR POLISHING SEMICONDUCTOR

(54) 発明の名称: 半導体研磨用組成物



(57) Abstract: Polishing scratches in the surface of a semiconductor device is reduced significantly without damaging the advantage of fumed silica, i.e. high polishing speed, even though fumed silica is contained as a polishing agent. When a wafer (3) mounted on a pad (2) stuck to a turn table (1) is polished by exerting a load on the wafer (3) by means of a pressure head (4) and rotating the pad (2) and the pressure head (4), a water dispersion liquid of fumed silica containing 15% or more by volume of fumed silica particles having a particle size of 100 nm or less based on the entire fumed silica particles is employed as a polishing composition (5) supplied onto the pad (2). Since aggregation of fumed silica due to an external load and/or long term storage scarcely takes place, polishing scratches in the surface of a polished semiconductor device, especially those having a diameter of 0.2 μ m or above, are scarcely produced and a high polishing speed is attained.

(57) 要約: 本発明の目的は、研磨剤としてヒュームドシリカを含有するにも係わらず、ヒュームドシリカの長所である高い研磨速度を損なうことなく、半

(続葉有)

WO 2005/093803 A1



ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

導体デバイス表面の研磨傷の発生を著しく減少させることである。研磨定盤1に貼付されたパッド2上にウエハ3を載せ、ウエハ3に加圧ヘッド4により荷重をかけ、パッド2と加圧ヘッド4とを回転させてウエハ3を研磨するに際し、パッド2上に供給される研磨用組成物5として、ヒュームドシリカ水分散液であって、粒径100nm以下のヒュームドシリカ粒子の含有量を、ヒュームドシリカ全粒子の15体積%以上含有する研磨用組成物を用いる。該組成物は、外的負荷および／または長期保存によるヒュームドシリカの凝集がほとんど起こらないので、半導体デバイス表面の研磨傷、特に径0.2μm以上の研磨傷をほとんど発生させることがなく、しかも高い研磨速度を有する。